

外置过热保护调节、降压型恒流驱动功率开关

主要特点

- 集成高压 500V MOSFET
- 集成高压自供电电路
- 无 VDD 电容设计
- 集成 600V 续流二极管设计
- ±5% 恒流精度
- 准谐振模式高效率工作
- 超低工作电流
- 优异的线电压和负载调整率
- 内部保护功能:
 - 逐周期电流限制 (OCP)
 - 前沿消隐 (LEB)
 - LED 短路保护
 - 过热保护 (OTP)
- 動装类型 SOP-7

典型应用

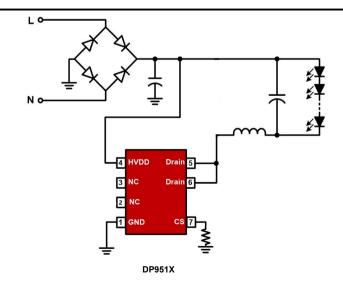
● LED 照明

典型应用电路

产品描述

DP951X 系列是高度集成的恒流 LED 功率开关,芯片采用了准谐振的工作模式,无需辅助绕组检测消磁。同时内部集成有高压 500V 功率 MOSFET 和高压自供电电路,简化了系统的设计和生产成本。芯片集成高精度的电感电流采样技术,可以获得高精度的恒流输出,且输出的线电压和负载调整率表现优异。

DP951X 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如: VDD 欠压保护功能 (UVLO)、逐周期电流限制 (OCP)、过热保护 (OTP)、CS 采样电阻短路保护,LED 短路保护等。





管脚封装



SOP-7

产品标记



DP951X 为产品名称:

DP951X 为产品名称; XXXXXX 第 1 个 X 表示年的最后一位,如 2019 为 4; 第 2 个 X 表示月,用 A-L 12 个字母表示;第 3、4 个 X 表示日期,如 01-31;最后两个 X 为晶圆批号追踪码。

输出功率表

产品型号	封装	最大输出电流	最低输出电压	
		72V 输出	120V 输出	取 版 棚 山 电压
DP9511M	SOP-7	130 mA	120 mA	
DP9511S		180 mA	150 mA	
DP9511A		220 mA	180 mA	30V
DP9511		260 mA	230 mA	
DP9512		300 mA	280 mA	

备注: 最大输出功率受限于芯片最高结温,且与环境温度和 PCB 有关,实际系统最大输出功率请以测试为准。

管脚功能描述

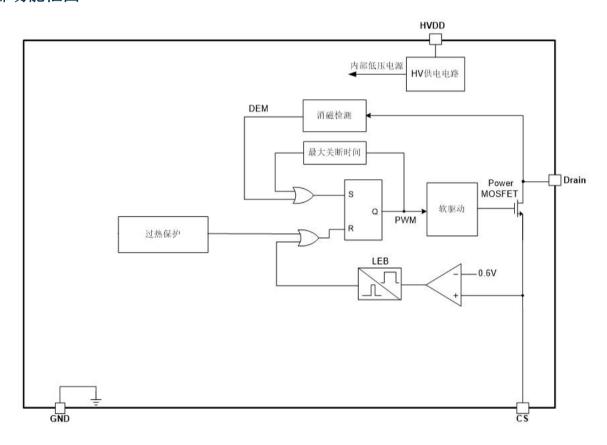
管脚	名称	I/O	描述	
1	GND	Р	芯片的参考地	
2	NC		非功能管脚,应用中悬空	
3	NC		非功能管脚,应用中悬空	
4	HVDD	Р	芯片高压供电管脚	
5,6	Drain	Р	内部功率 MOSFET 漏极输入管脚	
7	CS	I	电流采样输入管脚	



订货信息

型号	描述
DP9511M	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷
DP9511S	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷
DP9511A	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷
DP9511	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷
DP9512	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷

内部功能框图





极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
Drain 电压	-0.3 to 500	V
HVDD 电压	-0.3 to 650	V
CS,OTP 电压	-0.3 to 7	V
P _{Dmax} , 耗散功率@T _A =50°C (SOP-7) (备注 2)	0.6	W
Θ _{JA} 封装热阻结到环境 (SOP-7)	165	°C/W
芯片工作结温	150	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV

推荐工作条件

参数	数值	单位
工作结温	-40 to 125	°C

电气参数 (环境温度为 25 ℃,除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位	
供电部分 (HVDD 管脚)							
I _{VDD_st}	启动电流	VDD <v<sub>DD_Op</v<sub>		300	700	uA	
I _{VDD_Op}	工作电流	Fsw=7KHz	80	150	300	uA	
HV_{DD_ON}	HVDD 脚启动电压		10	11.5	13	V	
HV _{DD_OFF}	HVDD 脚关断电压		5.8	6.6	7.5	V	
T _{off_min}	最短关断时间	(备注 3)	0.6	1.0	1.4	us	
T _{on_max}	最长导通时间	(备注 3)		50		us	
T _{off_max}	最长关断时间		195	270	350	us	
电流采样部分	电流采样部分 (CS 管脚)						
T _{LEB}	电流采样前沿消隐时间	(备注 3)	300	500	700	ns	
V _{cs(max)}	峰值电流基准		590	600	610	mV	
T _{D_OC}	关断延时	(备注 3)		100		ns	



过热保护部分 (OTP)							
T _{SD}	智能温度调节阈值	(备注 3)		140		°C	
高压启动和IO	高压启动和 IC 供电部分 (HVDD管脚)						
I _{HV}	HV 充电电流	HVDD =20V		6		mA	
IHV_leak	HV 漏电流		10	40	60	uA	
高压 MOSFE	高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V _{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		500			V	
R _{dson}		DP9511M		22		Ω	
	导通阻抗	DP9511S		16			
		DP9511A		12		Ω	
		DP9511		8.5		Ω	
		DP9512		5		Ω	

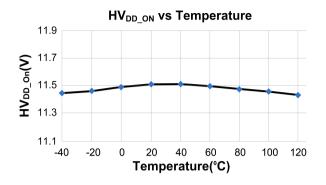
备注1:超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,可能会影响器件的可靠性。

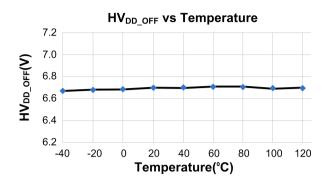
备注2: 最大耗散功率 P_{Dmax} =(T_{Jmax} - T_A)/ Θ_{JA} ,环境温度升高时最大耗散功率会随之降低。

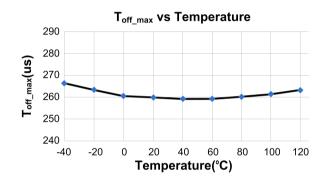
备注3: 参数取决于实际设计,在批量生产时进行功能性测试。

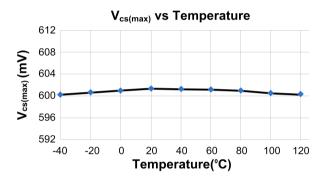


参数特性曲线











功能描述

DP951X 系列是一款高度集成的恒流 LED 功率开关,芯片采用了准谐振的工作模式,无需辅助绕组检测消磁,芯片同时集成 500V 功率开关和高压自供电电路,只需极少的外围器件即可达到优异的恒流特性,系统成本极低。

● HVDD 供电

DP951X 集成 650V 高压供电电路,功率 MOSFET 的栅极驱动直接通过高压供电电路供电,无需外置 VDD 电容。

● 恒流控制

DP951X 系列会逐周期采样电感电流,当电感电流达到电流比较器阈值电压 (V_{CS_max}=600mV) 时,立即关断功率 MOSFET,电感进入消磁状态,当电感电流消磁完成时,再开启下一个周期。系统工作在电感电流临界模式,因此,输出恒流值由以下公式决定:

$$I_{\text{CC_OUT}}\left(mA\right) = \frac{1}{2} \bullet \frac{V_{\text{cs(max)}}}{R_{cs}} = \frac{300mV}{R_{cs}\left(\Omega\right)}$$

其中:

Rcs---连接于 CS 管脚和 GND 管脚之间的采样电阻。

● 电流采样和前沿消隐

在每次功率 MOSFET 导通的瞬间,都会在采样电阻两端

电压与内部过流比较器进行比较控制输出电流。但在 MOSFET 导通瞬间也会产生由 MOFET 寄生电容和续流 二极管反向恢复电流造成的电压尖峰。为了避免驱动信号错误关断,芯片内部设计有前沿消隐时间。在此时间内部 (典型值 500ns),内部 PWM 比较器停止工作以保证驱动信号稳定导通。

● 消磁检测

DP951X 利用内部集成消磁检测电路,无需辅助绕组,极大减小了系统成本。

● 最长和最短关断时间

当功率 MOSFET 关断后,在 DP951X 内部设计有典型值 1us 的最短关断时间限制以避免干扰。同时,芯片内部典型的最长关断时间设计为 270us。

● 过热保护 (OTP)

DP951X 内部集成有过热保护功能。当芯片检测到结温超过 140°C,内部的输出电流基准则开始逐渐降低直至达到温度平衡。通过过热保护功能,限制了系统的最高温度并提高了系统的可靠性。

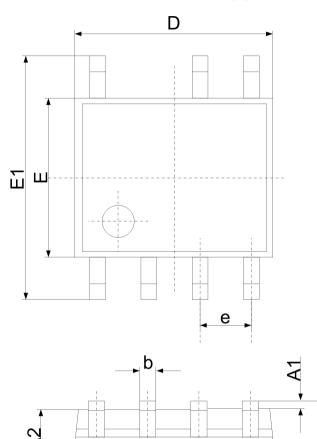
软驱动

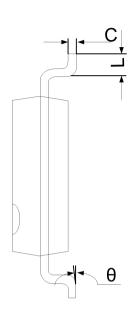
DP951X设计有软驱动电路有效地降低了EMI噪声。



封装尺寸







符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)		
च क	最小	最大	最小	最大	
Α	1.350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0.250	0.004	0.010	
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	
b	0.330	0.510	0.013	0.020	
С	0.170	0.250	0.006	0.010	
D	4.700	5.100	0.185	0.200	
E	3.800	4.000	0.150	0.157	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244	
е	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)		
L	0.400	1.270	0.016	0.050	
θ	0°	8°	0°	8°	